

Silicon Diode

S407

30V / 50mA

DATASHEET

OEM – SEL

Source: SEL Databook 1965



Silizium-Planar-Diode **S 407**

Ausführung

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode im Miniatur-Glasgehäuse. Kennzeichnung durch Farbringe — auf der Kathodenseite beginnend — nach dem internationalen Farbcode.

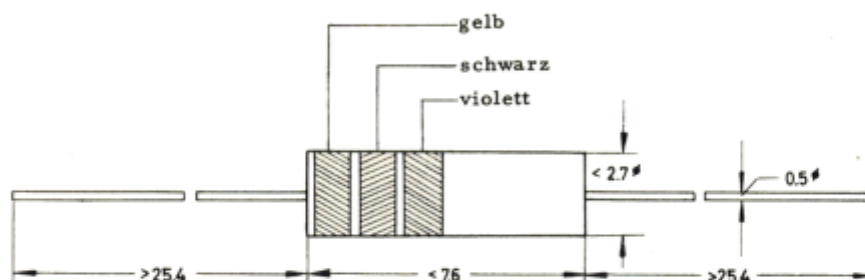
Verwendung

Diode für den Einsatz als schneller Schalter bei niedrigen Strömen.

Abmessungen

(Maße in mm)

Gehäuse DO-7



Grenzdaten

Verlustleistung	$T_u = 25\text{ °C}$	P	250	mW	
Sperrspannung	$T_u = 25\text{ °C}$	$I_R = 10\text{ }\mu\text{A}$	U_R	30	V
Spitzensperrspannung		$I_R = 100\text{ }\mu\text{A}$	U_{RM}	40	V
Durchlaßgleichstrom			I_F	50	mA
Durchlaßspitzenstrom		$f > 25\text{ Hz}$	I_{FM}	150	mA
Durchlaßstoßstrom		$t < 1\text{ s}$	i_{FS}	300	mA
Maximale Sperrschichttemperatur		$+T_J$	150	°C	
Minimale Gehäusetemperatur		$-T_G$	55	°C	
Maximale Lagertemperatur		$+T_s$	150	°C	
Minimale Lagertemperatur		$-T_s$	55	°C	

S 407**Statische Kenndaten bei $T_U = 25\text{ °C}$**

Sperrstrom	$U_R = 10\text{ V}$	I_R	< 50	nA
		I_{R^*}	< 3	μA
Durchlaßspannung	$I_F = 1\text{ mA}$	U_F	< 0,7	V
	$I_F = 10\text{ mA}$		< 1,0	V
	$I_F = 30\text{ mA}$		< 1,35	V
Wärmewiderstand		R_{thU}	0,5	$^{\circ}\text{C}/\text{mW}$

* $T_j = 100\text{ °C}$ **Dynamische Kenndaten bei $T_U = 25\text{ °C}$**

Diodenkapazität	$U_R = 0$ $f = 10\text{ MHz}$	C	< 6	pF
Sperrverzögerungszeit	von $I_F = 10\text{ mA}$ auf $I_R = 10\text{ mA}$ bis $I_R = 1\text{ mA}$	t_{rr}	< 15	ns

